

“高性能宽温 NANDFlash 闪存片”

成果登记公示信息

成果名称:	高性能宽温 NANDFlash 闪存片
完成单位:	广东全芯半导体有限公司
完成人员:	郭忠,何婉婷,苏龙钦,蔡文献,杨旭年,李锦光
研究起止日期:	2019-03-05 至 2021-03-20
成果应用行业:	信息传输、软件和信息技术服务业
社会经济目标:	电子信息
学科分类:	
评价单位:	河南省中科广汇科技成果评价中心
评价日期:	2024-04-07
成果简介:	本项目旨在研发一款高性能宽温 NAND Flash 闪存片,以满足在极端温度环境下对数据存储的高可靠性需求。项目将重点关注闪存片的温度适应性、读写速度、存储密度以及数据保持力等关键性能指标。 技术原理及路线: 本项目将采用先进的纳米技术和材料科学原理,通过优化闪存片的结构设计和制造工艺,提高其在宽温环境下的性能稳定性。具体技术路线包括材料选择、结构设计、制造工艺优化等方面。 项目创新点: 本项目的主要创新点在于: 采用新型宽温材料,提高闪存片在极端温度下的稳定性; 优化闪存片结构设计,降低温度对性能的影响; 引入先进的制造工艺,提高闪存片的读写速度和存储密度。 项目性能指标及对比: 与传统 NAND Flash 闪存片相比,本项目的性能指标将有以下显著提升: 工作温度范围更广,适应极端温度环境; 读写速度更快,提高数据处理效率; 存储密度更高,满足大容量存储需求; 数据保持力更强,确保数据长期可靠性。 项目实施方案: 本项目的实施将分为以下几个阶段: 前期调研与需求分析:深入了解市场需求和竞争对手情况,明确项目的研发目标和方向。 材料选择与制备:筛选适合宽温环境的材料,并进行制备和性能测试。 结构与仿真:根据材料性能和市场需求,设计闪存片的结构,并进行仿真验证。 制造工艺研究与优化:研究并优化闪存片的制造工艺,提高生产效率和产品质量。 性能测试与评估:对制备出的闪存片进行性能测试和评估,确保其满足项目指标要求。

	产业化准备与市场推广：完成产业化准备工作，制定市场推广策略，为产品的上市做好准备。
--	---